

PNP SILICON SMALL SIGNAL TRANSISTOR

Qualified per MIL-PRF-19500/392

Devices

2N3485A

2N3486A

Qualified Level

JAN
JANTX
JANTXV

MAXIMUM RATINGS

Ratings	Symbol	2N3485A 2N3486A	Unit
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	60	Vdc
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	60	Vdc
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5.0	Vdc
Collector Current -- Continuous	I_C	600	mAdc
Total Power Dissipation @ $T_A = +25^{\circ}\text{C}^{(1)}$ @ $T_C = +25^{\circ}\text{C}^{(2)}$	P_T	0.4 2.0	W W
Operating & Storage Junction Temperature Range	T_J, T_{stg}	-55 to +200	$^{\circ}\text{C}$

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristics	Symbol	Max.	Unit
Thermal Resistance Junction-to-Ambient	$R_{\theta JA}$	0.439	$^{\circ}\text{C/W}$
Junction-to-Case	$R_{\theta JC}$	87	$^{\circ}\text{C/W}$

1) Derate linearly 2.28 mW/ $^{\circ}\text{C}$ above $T_A = +25^{\circ}\text{C}$

2) Derate linearly 11.43 mW/ $^{\circ}\text{C}$ above $T_C = +25^{\circ}\text{C}$



TO-46*
(TO-206AB)

*See appendix A for
package outline

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristics	Symbol	Min.	Max.	Unit
-----------------	--------	------	------	------

OFF CHARACTERISTICS

Collector-Emitter Breakdown Voltage $I_C = 10 \text{ mAdc}$	$V_{(BR)CEO}$	60		Vdc
Collector-Base Cutoff Current $V_{CB} = 50 \text{ Vdc}$ $V_{CB} = 60 \text{ Vdc}$	I_{CBO}		10 10	ηAdc μAdc
Emitter-Base Cutoff Current $V_{EB} = 3.5 \text{ Vdc}$ $V_{EB} = 5.0 \text{ Vdc}$	I_{EBO}		50 10	ηAdc μAdc

2N3485A, 2N3486A JAN SERIES

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (con't)

Characteristics		Symbol	Min.	Max.	Unit
ON CHARACTERISTICS ⁽³⁾					
Forward-Current Transfer Ratio					
$I_C = 0.1 \text{ mA}$, $V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$	2N3485A		40		
	2N3486A		75		
$I_C = 1.0 \text{ mA}$, $V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$	2N3485A		40		
	2N3486A		100		
$I_C = 10 \text{ mA}$, $V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$	2N3485A	h_{FE}	40		
	2N3486A		100		
$I_C = 150 \text{ mA}$, $V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$	2N3485A		40	120	
	2N3486A		100	300	
$I_C = 500 \text{ mA}$, $V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$	2N3485A		40		
	2N3486A		50		
Collector-Emitter Saturation Voltage					
$I_C = 150 \text{ mA}$, $I_B = 15 \text{ mA}$		$V_{CE(sat)}$		0.4	Vdc
$I_C = 500 \text{ mA}$, $I_B = 50 \text{ mA}$				1.6	
Base-Emitter Saturation Voltage					
$I_C = 150 \text{ mA}$, $I_B = 15 \text{ mA}$		$V_{BE(sat)}$		1.3	Vdc
$I_C = 500 \text{ mA}$, $I_B = 50 \text{ mA}$				2.6	

DYNAMIC CHARACTERISTICS

Small-Signal Forward Current Transfer Ratio					
$I_C = 1.0 \text{ mA}$, $V_{CE} = 10 \text{ Vdc}$, $f = 1.0 \text{ kHz}$	2N3485A	h_{fe}	40		
	2N3486A		100		
Magnitude of Small-Signal Forward Current Transfer Ratio					
$I_C = 50 \text{ mA}$, $V_{CE} = 20 \text{ Vdc}$, $f = 100 \text{ MHz}$		$ h_{fe} $	2.0	10	
Output Capacitance					
$V_{CB} = 10 \text{ Vdc}$, $I_E = 0$, $100 \text{ kHz} \leq f \leq 1.0 \text{ MHz}$		C_{obo}		8.0	pF
Input Capacitance					
$V_{EB} = 2.0 \text{ Vdc}$, $I_C = 0$, $100 \text{ kHz} \leq f \leq 1.0 \text{ MHz}$		C_{ibo}		30	pF

(3) Pulse Test: Pulse Width = 300 μ s, Duty Cycle $\leq$ 2.0%.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9